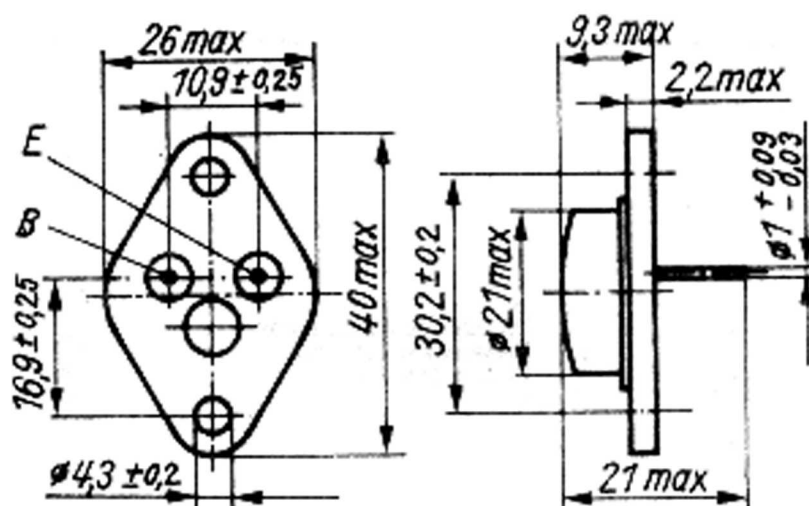


SD 812

Silizium-npn-Leistungstransistor für Batteriezündanlagen.

Der Einsatz erfolgt in Darlingtonschaltungen.



Kollektor am Gehäuse

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 2,5 \text{ K/W}$

Grenzwerte: (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

U_{CEM} ($R_{BE} \leq 100 \Omega$)	500	V
U_{CEO} ($I_B = 0$)	200	V
I_C	4	A
I_{CM}	6	A
I_{BM}	2,5	A
P_{tot} ($\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$)	50	W
ϑ_j	-40 ... 150	$^\circ\text{C}$
ϑ_a	-40 ... 85	$^\circ\text{C}$

Elektrische Kennwerte ($\vartheta_c = -25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

U_{CEsat} ($I_C = 1 \text{ A}, I_B = 0,2 \text{ A}$)	2,5	V
U_{BEsat} ($I_C = 3,2 \text{ A}, I_B = 0,8 \text{ A}$)	1,2	V